Проводимость на переменном токе и электронный парамагнитный резонанс соединений Cd_{1-*x*}Fe_{*x*}Te

© П. Жуковски, Я. Партыка, П. Венгерэк, Т. Колтунович, Ю. Сидоренко*, В. Стельмах*, Н. Лапчук*

Люблинский технический университет, 20-618 Люблин, Польша * Белорусский государственный университет, 220050 Минск, Беларусь

(Получена 30 марта 2006 г. Принята к печати 21 августа 2006 г.)

Представлены результаты измерений частотных зависимостей проводимости и спектров электронного парамагнитного резонанса материалов $Cd_{1-x}Fe_xTe$ (0.01 $\leq x \leq$ 0.05) при комнатной температуре. Установлено, что в области концентраций $0.003 \leq x \leq 0.05$ появляется несимметричная линия поглощения ЭПР с $g \approx 3.9$, обнаруживается ее гистерезис, а образцы намагничиваются. Линия с $g \approx 3.9$ связана с зарядовым состоянием атомов железа 3⁺, которое проявляется в тетраэдрах с тремя атомами Fe.

PACS: 76.30.Fc, 72.80.Ey, 72.60.+g

Для образцов Cd_{1-x}Fe_xTe с концентрацией Fe x < 0.03 ранее нами была обнаружена дополнительная поляризация, вызванная прыжковым обменом зарядами [1]. В области концентраций x < 0.01 энергия термической активации поляризации составляла ~ 0.38 эВ, а в области 0.02 < x < 0.03 около 0.14 эВ. Дополнительная поляризация с такими энергиями активации была обусловлена прыжковым обменом зарядами между дефектами, в состав которых входили 1 и 2 атома железа соответственно. Увеличение числа атомов железа в дефекте с 1 до 2 приводит, как видно, к уменьшению глубины залегания дефектного уровня. Прыжковый обмен зарядами может проявляться и в прыжковой проводимости на переменном токе. На рис. 1 представлены зависимости удельной проводимости σ от частоты f для образцов с разной концентрацией железа. Как видно из этого рисунка, для материалов с x ≤ 0.03 наблюдается рост проводимости с частотой, а для образцов с $x \ge 0.035$ проводимость не зависит от частоты.

Рост σ с частотой имеет место в случае прыжковой проводимости, а в случае типичной для полупроводников проводимости путем переноса носителей в одной из разрешенных зон ее величина не должна изменяться до частоты ~ 100 МГц [2].

Выполненные нами исследования проводимости показали, что в образцах с $x \le 0.03$ происходит прыжковый перенос зарядов. При увеличении x до 0.035 этот перенос прекращается, уступая место переносу зарядов в разрешенной зоне. Это означает уменьшение энергии активации, связанное с глубиной залегания энергетических уровней дефектов в запрещенной зоне. При $x \ge 0.035$ уровни становятся мелкими, что приводит к росту проводимости на 8 порядков на частоте 1 кГц и исчезновению ее частотной зависимости. Так как вследствие роста концентрации атомов Fe с 0.03 до 0.035 запрещенная зона расширяется всего на ~ 0.015 зВ, а энергия активации уменьшается с 0.14 зВ [1] до 0.01–0.05 зВ, эти процессы между собой не связаны. Для объяснения перехода от прыжкового переноса при $x \le 0.03$ к зонной

проводимости при $x \ge 0.035$ необходимо принять, что в этом случае появляется новый тип дефектов, содержащих 3 атома Fe, что вызывает уменьшение глубины залегания энергетического уровня в запрещенной зоне.

Магнитные свойства соединения $Cd_{1-x}Fe_x$ Те $(0.0035 \le x \le 0.05)$ были исследованы методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Измерения проводились при комнатной температуре.

Для образцов с концентрациями Fe $0.0035 \le x \le 0.03$ в спектрах ЭПР не наблюдается линий поглощения. Это может быть связано, скорее всего, с тем, что в этой области концентраций ионы Fe имеют зарядовое состояние 2+, которое не является парамагнитным.

В образцах с x = 0.03 наблюдается широкая линия с *g*-фактором $g \approx 2.0$ (ширина $\Delta B \approx 300-325$ Гс), на которую накладываются шесть узких линий с $\Delta B \approx 25-30$ Гс. Узкие линии могут быть связаны с присутствием ионов Mn, которые в этом случае являются остаточной примесью [3]. В области низких полей наблюдается несимметричная линия с g = 3.9.



Puc. 1. Частотная зависимость проводимости соединений $Cd_{1-x}Fe_x$ Te c x = 0.01 (1), 0.02 (2), 0.03 (3), 0.035 (4), 0.045 (5), 0.05 (6). Температура измерений 300 К.



Рис. 2. Спектр ЭПР образца $Cd_{1-x}Fe_xTe$ (x = 0.035) при увеличении поля (1) и при его уменьшении (2). Штриховая линия — уровень, принятый за нулевой.



Рис. 3. Спектр ЭПР $Cd_{1-x}Mn_x$ Те (x = 0.5). Штриховая линия — уровень, принятый за нулевой.

Такая же линия с большим значением *g*-фактора обнаружена в образцах с концентрациями железа 0.035 и 0.045 (рис. 2). Установлено, что эта линия имеет гистерезис. На рис. 2 кривая *1* получена при росте индукции магнитного поля *B*, а кривая 2 при уменьшении индукции. Обнаружено, что образцы с $0.030 \le x \le 0.045$ намагничиваются. Намагничивание образцов и явление гистерезиса (с учетом низких концентраций Fe) указывают на то, что исследованные материалы могут являться спиновыми стеклами.

Было проведено сравнение спектров ЭПР соединений $Cd_{1-x}Mn_x$ Те, которые обладают антиферромагнитными свойствами, и $Cd_{1-x}Fe_x$ Те. Для материалов $Cd_{1-x}Mn_x$ Те спектры ЭПР имеют симметричную линию с $g \approx 2.002$, ширина которой возрастает с ростом концентрации переходного металла и уменьшается с повышением температуры [4]. Для исследований был выбран образец с содержанием атомов Mn x = 0.5. Спектр ЭПР этого образца представлен на рис. 3.

Для исследования анизотропии магнитных свойств соединений $Cd_{1-x}Fe_x$ Те и $Cd_{1-x}Mn_x$ Те использовалась следующая процедура. Из рис. 2 и 3 были определены значения индукции магнитного поля B_m , соответствующие максимуму спектра ЭПР. Затем при постоянном значении внешнего поля B_m регистрировалась зависи-

мость амплитуды сигнала ЭПР *A* от угла поворота образца φ , шаг поворота составлял 10°. Таким образом была получена угловая зависимость амплитуды сигнала ЭПР $A(\varphi)$ для образцов $Cd_{1-x}Fe_xTe$ (x = 0.035) — рис. 4 и $Cd_{1-x}Mn_xTe$ (x = 0.5) — рис. 5. Значения магнитного поля B_m и сигнала ЭПР A = 0 показаны на рис. 2 и 3.

Как видно из рис. 4, зависимость $A(\varphi)$ для $Cd_{1-x}Fe_x$ Те похожа на асимметричную восьмерку, и при последующих оборотах образца ее форма не изменяется. Это связано с процессами намагничивания и размагничивания образца при его повороте в постоянном магнитном поле.



Рис. 4. Угловая зависимость амплитуды сигнала A, измеренная в точке B_m (рис. 2), для образца $Cd_{1-x}Fe_xTe$ (x = 0.035). I — первый цикл, 2 — второй. Сплошная линия — результаты компьютерного моделирования по формулам (1)–(5).



Рис. 5. Угловая зависимость амплитуды сигнала A, измеренная в точке B_m (рис. 3), для образца $Cd_{1-x}Mn_xTe$ (x = 0.5). I — первый цикл, 2 — второй.

Известно [5], что в магнитном материале индукция есть

$$B = \mu_0 H_m + \mu_0 J. \tag{1}$$

В нашем случае $\mu_0 H_m$ соответствует значению B_m , показанному на рис. 2, J — величина вектора намагниченности, μ_0 — магнитная восприимчивость. В магнитных материалах J является функцией напряженности магнитного поля H, которая называется петлей гистерезиса J(H).

Характерные точки петли гистерезиса:

- намагниченность насыщения $J_s = J(H = \infty)$,
- остаточная намагниченность $J_r = J(H = 0)$,
- коэрцитивное поле H_c , для которого $J(H_c) = 0$.

Из зависимости $A(\varphi)$, представленной на рис. 4, следует, что материал $Cd_{1-x}Fe_xTe$ (x = 0.035) обладает петлей гистерезиса. При увеличении внешнего магнитного поля до значения B_m , при котором проводилась регистрация $A(\varphi)$, материал намагничивается до $J(H_m = B_m/\mu_0)$. После поворота образца на угол φ на вектор **J** действует магнитное поле с напряженностью

$$H = H_m \cos \varphi = \frac{B_m}{\mu_0} \cos \varphi.$$
 (2)

Если в нашем образце значение вектора поляризации определяется петлей гистерезиса, то

$$J(\varphi) = J\left(H = \frac{B_m}{\mu_0}\cos\varphi\right).$$
 (3)

Существенным в явлении ЭПР является значение индукции магнитного поля в направлении, параллельном вектору напряженности электрического поля микроволн, поглощенных исследованным объектом. При повороте образца на угол φ вектор индукции магнитного поля

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_m + \mu_0 \, \mathbf{J}(\boldsymbol{\varphi}) \tag{4}$$

не параллелен \mathbf{B}_m . Интересующее нас значение получаем с учетом проекции $\mathbf{J}(\varphi)$ на направление \mathbf{B}_m :

$$B = B_m + \mu_0 J(\varphi) \cos \varphi.$$
 (5)

Проанализируем зависимость $A(\varphi)$, полученную для $Cd_{1-x}Fe_xTe$ (x = 0.035) — см. рис. 4. Как следует из формул (3) и (5), при намагничивании образца внешним полем $H_m = B_m/\mu_0$ магнитная индукция внутри образца составляет $B_m + \mu_0 J(H_m = B_m/\mu_0)$. При повороте образца на угол φ индукция, вызывающая явление ЭПР, уменьшается, во-первых, вследствие уменьшения поляризации в соответствии с петлей гистерезиса, а вовторых, в связи с уменьшением проекции вектора $J(\varphi)$ на направление внешнего поля B_m . Уменьшение полявнутри образца приводит к смещению точки измерений на спектре ЭПР (рис. 2) в сторону меньших, чем B_m ,



Рис. 6. Угловая зависимость амплитуды сигнала, измеренная в точке B_m (рис. 2), для образца $Cd_{1-x}Fe_xTe$ (x = 0.045). *1* — первый цикл, 2 — второй. Сплошная линия — результаты компьютерного моделирования по формулам (1)–(5).

значений поля. При достижении угла $\varphi = 90^{\circ}$ проекция магнитного поля на направление электрического поля внутри образца сравнивается с внешним полем — см. формулу (5). При $\varphi > 90^{\circ}$ индукция уменьшается все медленнее, и при угле φ_{\min} получаем минимальное ее значение. Зависимость $A(\varphi)$ при φ_{\min} также достигает минимума:

$$A(\varphi_{\min}) = \min$$
.

Для образца с $x = 0.035 \ \varphi_{\min} = 150^\circ$, а для x = 0.045 (рис. 6) $\varphi_{\min} = 110^\circ$. Дальнейший рост φ приводит к тому, что значение *B* начнет возрастать. При достижении угла φ_c , при котором $(B_m/\mu_0) \cos \varphi_c = -H_c$ — напряженность коэрцитивного поля, поле внутри образца возрастает до значения внешнего поля $B = B_m$, вектор намагниченности J = 0, а амплитуда достигает значения, которое принимала при $\varphi = 90^\circ$, $A(\varphi_c) = A(90^\circ)$. Из рис. 4 следует, что для $x = 0.035 \ \varphi_c = 160^\circ$, а для $x = 0.045 \ \varphi_c = 140^\circ$ (рис. 6). Это означает, что петля гистерезиса является широкой, а коэрцитивное поле H_c составляет для образца с x = 0.035 около $1 \cdot 10^5$ А/м (для $x = 0.045 \ H_c = 7.6 \cdot 10^4$ А/м).

При небольшом дальнейшем росте φ выше φ_c происходит намагничивание образца во внешнем магнитном поле B_m до значения $J_m(H_m = B_m/\mu_0)$, чему соответствует рост амплитуды $A(\varphi)$. Дальнейший рост φ выше φ_c приводит к повторению вышеописанной ситуации.

Угловая зависимость $A(\varphi)$ для материала $Cd_{1-x}Mn_x$ Те (x = 0.5), представленная на рис. 5, имеет форму окружности. Этот материал проявляет антиферромагнитные свойства. Поле внутри образца равно значению внешнего поля, а амплитуда спектра ЭПР в том случае не зависит от угла установки образца в магнитное поле.

Параметры спектров ЭПР образцов Cd_{1-x}Fe_xTe

x	<i>H</i> _c , А/м	J_s , A/M	<i>Вs</i> , Тл	ΔB , Тл
0.035 0.045	$\frac{10^5}{7.6\cdot10^4}$	$\begin{array}{c} 2.15 \cdot 10^{4} \\ 2.77 \cdot 10^{4} \end{array}$	0.027 0.035	0.04 0.036

Для образца $Cd_{1-x}Fe_xTe$ (x = 0.045) также получена зависимость амплитуды спектра ЭПР от угла поворота образца в магнитном поле (рис. 6). Эта зависимость подобна представленной на рис. 4 для образца с содержанием железа x = 0.035.

Оценим намагниченность образцов в состоянии насыщения [5]:

$$J_s = C\mu_B n, \tag{6}$$

где *С* — концентрация атомов железа в исследуемом образце, $\mu_B = 9.25 \cdot 10^{-24} \,\text{A} \cdot \text{m}^2$ — магнетон Бора, n = 2.218 — число магнетонов Бора на один атом железа.

В соединениях $Cd_{1-x}Fe_x$ Те концентрация атомов составляет $\sim 6 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$. Для образца с концентрацией x $C = x \cdot 3 \cdot 10^{26} \text{ m}^{-3}$. Подставляя значения C, μ_B и n в формулу (6), получаем значение J_s , а из формулы (1) — соответствующее значение индукции магнитного поля B_s .

Изменения индукции магнитного поля внутри образца, возникающие вследствие намагничивания и размагничивания в процессе его поворота, могут достигать значений 0.027 Тл для x = 0.035 и 0.035 Тл для x = 0.045. Эти величины сравнимы с шириной ΔB спектров ЭПР, значения которых приведены в таблице.

Таким образом, обнаруженные в работе угловые зависимости сигнала спектров ЭПР $Cd_{1-x}Fe_xTe$, представленные на рис. 4, 6, вызваны циклическим намагничиванием и размагничиванием образцов в процессе их поворота в магнитном поле.

На основании уравнений (1)–(5) было выполнено компьютерное моделирование угловых зависимостей амплитуды ЭПР $A(\phi)$, результаты которого представлены в виде сплошных линий на рис. 4 и 6. Как видно из рисунков, получено достаточно хорошее согласие с экспериментальными данными. Из сравнения экспериментальных и расчетных зависимостей $A(\phi)$ следует, что в образце с x = 0.045 наблюдается небольшая анизотропия сигнала, которая не была учтена в моделировании (рис. 6).

При компьютерном моделировании не был также учтен размагничивающий фактор [6], поскольку его расчет был затруднен в связи с неправильной формой образцов. Учет размагничивающего фактора может уменьшить в несколько раз величину определенного экспериментально коэрцитивного поля. Остальные величины, приведенные в таблице, при этом не изменятся.

Для образца $Cd_{1-x}Fe_x$ Te с x = 0.05 линия с g = 3.9исчезает и появляется широкая симметричная линия в области $g \approx 2.5$. Ширина этой линии составляет ~ 2500 Гс. В соединении $Cd_{1-x}Mn_x$ Те такая ширина линии поглощения наблюдается при концентрации переходного металла x = 0.7. Ширина линии указывает на то, что локальная концентрация атомов железа в исследованном образце должна быть сравнима с концентрацией Mn в $Cd_{0.3}Mn_{0.7}$ Те. Это означает, что железо склонно не только к коррелированному микроскопическому размещению в тетраэдрах [1], но и к образованию скоплений с высокой локальной концентрацией. Появление широкой линии с $g \approx 2.5$ свидетельствует о том, что образец $Cd_{1-x}Fe_x$ Те с x = 0.05 стал, как и материал $Cd_{1-x}Mn_x$ Те, антиферромагнитным.

Обнаруженная в описанных выше исследованиях склонность атомов Fe к коррелированному расположению в кристаллической решетке CdTe может послужить в качестве основы для объяснения факта низкой растворимости атомов Fe в Cd_{1-x}Fe_xTe, для которых однофазный твердый раствор существует только до $x \leq 0.05$ [7].

Таким образом, из измерений диэлектрической проницаемости, результаты которых представлены в [1], проводимости на переменном токе и электронного парамагнитного резонанса мы установили три области концентраций, отличающихся количеством атомов Fe в элементарном тетраэдре $Cd_{1-x}Fe_x$ Te, а также взаимную корреляцию этих свойств.

Первая область, $x \le 0.03$, характеризуется температурной и частотной зависимостью проводимости и диэлектрической проницаемости, что свидетельствует о прыжковом механизме переноса зарядов. На основании результатов изменений зависимости энергии активации диэлектрической проницаемости от концентрации атомов Fe предложено существование в этой области дефектов, включающих 1 и 2 атома железа. В этой области концентраций Fe не наблюдается линий поглощения электронного парамагнитного резонанса. Это означает, что одиночные атомы железа и их пары находятся в непарамагнитном зарядовом состоянии 2+.

Появление в области концентраций $0.03 \le x \le 0.045$ несимметричной линии ЭПР с g = 3.9, ее гистерезис и намагничивание образцов связаны с ферромагнитным состоянием железа Fe³⁺. Это означает, что в образцах происходит дальнейшая перестройка тетраэдров с появлением в них трех атомов Fe. На это указывает и изменение характера проводимости на переменном токе — переход от прыжковой к зонной проводимости, а также исчезновение дополнительной поляризации материалов.

Необходимо отметить, что в образце с x = 0.03 одновременно существуют дефекты с двумя атомами Fe, по которым происходит прыжковая проводимость, и с тремя атомами Fe, обусловливающие линию ЭПР с $g \approx 3.9$.

Увеличение *x* до 0.05 приводит к появлению линии ЭПР шириной ~ 2500 Гс. Эта линия связана с появлением кластеров с высокой концентрацией железа.

Список литературы

- П. Жуковский, Я. Партыка, П. Венгерэк, Ю. Сидоренко, Ю. Шостак, А. Родзик. ФТП, 33, 270 (1999).
- [2] Н. Мотт, Э. Дэвис. Процессы в некристаллических веществах (М., Мир, 1982).
- [3] A. Twardowski. Sol. St. Commun., 64, 63 (1987).
- [4] N. Samarth, J.K. Furdyna. Phys. Rev. B, 37, 9227 (1988).
- [5] С.А. Уэрт, Р.М. Томсон. *Физика твердого тела* (М., Мир, 1970).
- [6] В.И. Чечерников. *Магнитные измерения* (М., Изд-во МГУ, 1969).
- [7] A. Mycielski. J. Appl. Phys., 63 (8), 3279 (1988).

Редактор Л.В. Шаронова

The alternating current conductivity and electron spin resonance $Cd_{1-x}Fe_xTe$ compounds

P. Zhukovskii, Ya. Partyka, P. Vengerek, T. Koltunovich, Yu. Sidorenko*, V. Stelmakh* N. Lapchuk*

Technical University of Lublin 20-618 Lublin, Poland * Belarusian State University 220050 Minsk, Belarus